

Содержание

- XXVII Международный симпозиум „Нанопизика и наноэлектроника“, Н. Новгород, 13–16 марта 2023 г.

Здоровейцев Д.А., Вихрова О.В., Данилов Ю.А., Лесников В.П., Нежданов А.В., Парафин А.Е., Планкина С.М.

Получение и исследование свойств слоев GaAs, легированных висмутом 399

Гудовских А.С., Уваров А.В., Баранов А.И., Вячеславова Е.А., Максимова А.А., Кириленко Д.А.

Плазмохимическое атомно-слоевое осаждение слоев InP и многослойных наноструктур InP/GaP на кремнии . . . 406

Смагина Ж.В., Степихова М.В., Зиновьев В.А., Дьяков С.А., Родякина Е.Е., Шенгуров Д.В., Кацюба А.В., Новиков А.В.

Люминесцентные свойства упорядоченных массивов кремниевых дисковых резонаторов со встроенными в них GeSi квантовыми точками 414

Фадеев М.А., Янцер А.А., Дубинов А.А., Козлов Д.В., Румянцев В.В., Михайлов Н.Н., Гавриленко В.И., Морозов С.В.

Двухчастотное стимулированное излучение в гетероструктуре Hg(Cd)Te/CdHgTe 421

Комков О.С., Якушев М.В.

Фотомодуляционная оптическая спектроскопия варизонных гетероструктур CdHgTe 426

Козлов Д.В., Жолудев М.С., Мажукина К.А., Алешкин В.Я., Гавриленко В.И.

Температурное гашение терагерцовой фотолюминесценции мелких акцепторов в твердом растворе HgCdTe 432

Жолудев М.С., Козлов Д.В., Морозов С.В., Янцер А.А.

Расчет резонансных состояний двухвалентного кулоновского акцептора в узкозонном твердом растворе HgCdTe . . 438

Калинников М.А., Лобанов Д.Н., Кудрявцев К.Е., Андреев Б.А., Юнин П.А., Красильникова Л.В., Новиков А.В., Скороходов Е.В., Красильник З.Ф.

Особенности формирования объемных слоев $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ в зоне несмешиваемости твердых растворов ($x \sim 0.6$) методом молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота 444

Пермякова О.О., Рогожин А.Е., Мяконьких А.В., Руденко К.В.

Деградация значения сопротивления в низкоомном состоянии в структуре на основе $\text{HfO}_2/\text{HfO}_x\text{N}_y$ 451

Жукавин Р.Х., Цыпленков В.В., Ковалевский К.А., Астров Ю.А., Лодыгин А.Н., Шуман В.Б., Порцель Л.М., Абросимов Н.В., Шастин В.Н.

Двойные доноры магния в кремнии как потенциальная активная среда в терагерцовом диапазоне 455

Чукеев М.А., Храмцов Е.С., Чжэн Шимин, Игнатьев И.В., Елисеев С.А., Ефимов Ю.П.

Влияние электрического поля на экситоны в квантовой яме при дополнительном оптическом возбуждении 461

- Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Швец В.А., Марин Д.В., Якушев М.В., Рыхлицкий С.В.

Эллипсометрический *in situ* контроль процессов роста буферных слоев ZnTe и CdTe в технологии молекулярно-лучевой эпитаксии кадмий-ртуть-теллура 469

- Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Калинушкин В.П., Гладилин А.А., Уваров О.В., Миронов С.А., Ильичев Н.Н., Студеникин М.И., Сторожевых М.С., Гаврищук Е.М., Иконников В.Б., Тимофеева Н.А.

Люминесцентные характеристики легированного хромом с помощью высокотемпературной диффузии CVD–ZnSe . . 476

- Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Берковиц В.Л., Кособукин В.А., Улин В.П., Алексеев П.А., Солдатенков Ф.Ю., Нащекин А.В., Хахулин С.А., Комков О.С.

Обнаружение клиновидных нанокластеров золота на поверхности GaAs и их изучение с помощью поляризационной спектроскопии плазмонов 484

Ружевич М.С., Фирсов Д.Д., Комков О.С., Мынбаев К.Д., Варавин В.С., Якушев М.В.

Фотолюминесценция эпитаксиальных пленок $\text{Cd}_{0.3}\text{Hg}_{0.7}\text{Te}$, легированных мышьяком 491

- Физика полупроводниковых приборов

Самарцев И.В., Звонков Б.Н., Байдусь Н.В., Чигинева А.Б., Жидяев К.С., Дикарева Н.В., Здоровейцев А.В., Рыков А.В., Планкина С.М., Нежданов А.В., Ершов А.В.

InGaAs фотодиод с пониженным темновым током на диапазон 1.17–1.29 мкм с дискретным метаморфным буферным слоем 495

Матвеев Б.А., Ратушный В.И., Рыбальченко А.Ю.

Пространственное распределение интенсивности электролюминесценции и внутренний квантовый выход во флип-чип диодах на основе двойных гетероструктур InAsSbP/InAsSb с удаленной подложкой 501

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

**Снигирев Л.А., Берт Н.А., Преображенский В.В.,
Путятто М.А., Семягин Б.Р., Чалдышев В.В.**

Влияние промежуточного низкотемпературного нагрева на преципитацию в нестехиометрическом GaAs 507

● **Персоналии**

Ефим Лазаревич Портной 513